

	<h2 style="color: red;">FDFME3N311ZT</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDFME3N311ZT
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET
	Datenblätter:  FDFME3N311ZT.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 15000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






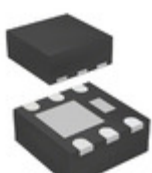
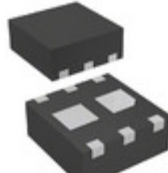
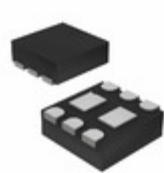
Spezifikationen

Teilenummer	FDFME3N311ZT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (1.6x1.6)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	299 mOhm @ 1.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDFME3N311ZT-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	75pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 1.8A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)

FDFME3N311ZT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFME3N311ZT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFME3N311ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFME3N311ZT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDFMS2P102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFMJ2P023Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.9A 6MLP</p>	 <p>FDFMA3W109 FAIRCHILD FDFMA3W109 FAIRCHILD</p>	 <p>FDFS20102A FAIRCHI FDFS20102A FAIRCHI</p>
 <p>FDFME3N311ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET</p>	 <p>FDFMJ2P023Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.9A 6MLP</p>	 <p>FDFMA3P029Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p>FDFME2P823ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p>

FDFME3N311ZT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDFME3N311ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFME3N311ZT Datenblatt	FDFME3N311ZT-Datenblätter	FDFME3N311ZT PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFME3N311ZT
FDFME3N311ZT Electronic	FDFME3N311ZT-Komponenten	FDFME3N311ZT-Verteiler	FDFME3N311ZT-Bild	FDFME3N311ZT-Teil
FDFME3N311ZT Preis	FDFME3N311ZT Hersteller	FDFME3N311ZT Bild	FDFME3N311ZT Aktie	FDFME3N311ZT Inventar
FDFME3N311ZT Neu	FDFME3N311ZT Original	FDFME3N311ZT garantiert	FDFME3N311ZT RFQ	FDFME3N311ZT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited